Исходные данные

Напряжение питания ИВЭП: $E_{\Pi} \coloneqq 115~$ В

Диапазон колебаний напряжения питания: $E_{\pi max} := E_{\pi} + E_{\pi} \cdot 0.3 = 149.5$ В

$$E_{\pi min} := E_{\pi} - E_{\pi} \cdot 0.3 = 80.5 \text{ B}$$

Частота: f := 400 Гц

Частота преобразования: $\mathbf{f}_{\pi p} \coloneqq 65 \cdot 10^3 \quad \Gamma_{\Pi}$

Напряжение нагрузки ИВЭП: $U_{_{
m H}} \coloneqq 9 - B$

Величина допустимого отклонения значения выходного напряжения: $\Delta U_{_{
m H}} := U_{_{
m H}} \cdot 0.02 = 0.18 \;\; {\sf B}$

Ток нагрузки ИВЭП: $I_{H} \coloneqq 2$ A

Температура окружающей среды: $T_{OKC1} := 233$ К $T_{OKC2} := 343$ К

Нестабильность выходного напряжения при изменении Еп: $\delta U_{\rm F} \coloneqq 0.02~{\rm B}$

Нестабильность выходного напряжения при изменении Iн: $\delta U_{\text{I}} := 0.03~\text{B}$

Параметры микросхемы

Номинальный ток питания микросхемы: $I_{MH} := 11 \cdot 10^{-3}$ А

Максимальный входной ток микросхемы: $I_{\text{mmax}} := 17 \cdot 10^{-3}$ А

Максимальный выходной ток микросхемы: $I_{\text{выхmax}} := 1$ A

Номинальное напряжение питания микросхемы: $U_{\mathrm{MH}} \coloneqq 9$ В

Максимальное напряжение питания микросхемы: $U_{mmax} := 30 \, \mathsf{B}$

Максимальное выходное напряжение микросхемы: $U_{\text{выхmax}} \coloneqq 5 \ B$

Максимально допустимая температура микросхемы: $T_{mmax} := 343$ K

Минимально допустимая температура микросхемы: $T_{mmin} \coloneqq 233$ K

Амплитуда пилообразного напряжения генератора: $U_{amпл} := 1.7 \, \, \mathsf{B}$

Гистерезис питания микросхемы: $\Delta U_{\Gamma} \coloneqq 0.8~$ В

Пусковой ток микросхемы: $I_{\Pi VCK} := 0.5 \cdot 10^{-3}$ А

Напряжение включения микросхемы: $U_{BKJ} := 16 \ B$

Максимальный выходной ток микросхемы с датчика тока: $I_{\text{выхmax}_{\Pi}} \coloneqq 2 \cdot 10^{-6} \text{ A}$

Опорное напряжение УСР микросхемы: $U_{OH} := 2.5$ В

Электрический расчёт

Определяем суммарную мощность нагрузки:
$$P_{_{\mathbf{H}}} := I_{_{\mathbf{H}}} \cdot U_{_{\mathbf{H}}} + I_{_{\mathbf{M}\mathbf{H}}} \cdot U_{_{\mathbf{M}\mathbf{H}}} = 18.099$$
 B_{T}

Задаёмся ориентировочным значением КПД:
$$\eta := 0.85$$

Определяем максимальное значение преобразуемой мощности с учётом дополнительных потерь в ИВЭП:

$$P_{\Pi p} := \frac{P_H}{n} = 21.293$$
 B

Расчитываем трансформатор. Выбираем сердечник МП-140.

Магнитная индукция насыщения: $B_S := 0.7 \text{ T}$

Остаточная индукция: $B_r := 0.03$ T

Магнитная постоянная:
$$\mu_0 := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} = 1.257 \times 10^{-6}$$
 Гн/м

Максимальная рабочая индукция:
$$B_m := 0.8 \cdot B_S = 0.56$$
 Т

Относительная магнитная проницаемость:
$$\mu := 140$$
 Гн/м

Максимальная напряжённость:
$$H_m := \frac{B_m}{\mu \cdot \mu_0} = 3.183 \times 10^3 \quad \text{A/m}$$

Объём сердечника:
$$V_{cepд} := \frac{2 \cdot P_{\Pi p}}{B_m \cdot H_m \cdot f_{\Pi p}} = 3.675 \times 10^{-7} \text{ м^3}$$

Типоразмер сердечника - тороидальный МП13х7х5.

$$D := 13 \cdot 10^{-3} \text{ M}$$
 $d := 7 \cdot 10^{-3} \text{ M}$ $h := 5 \cdot 10^{-3} \text{ M}$

Объём сердечника-стали:
$$V_{\text{стали}} := \frac{\pi \cdot D^2 - \pi \cdot d^2}{4} \cdot h = 4.712 \times 10^{-7}$$
 м^3

Площадь поперечного сечения:
$$S_{\text{стали}} := h \cdot \frac{(D-d)}{2} = 1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

Площадь окна:
$$S_{\text{окна}} := \frac{\pi \cdot d^2}{4} = 3.848 \times 10^{-5} \text{ м^2}$$

Средняя длина - длина силовой линии:
$$1_{cp} := \frac{D+d}{2} \cdot \pi = 0.031$$
 м

Длина одного витка:
$$l_0 := 2 \cdot h + (D - d) = 0.016$$
 М

Площадь охлаждения:
$$S_{OXJ} := \pi \cdot D \cdot h + \frac{\pi \cdot D^2}{2} = 4.697 \times 10^{-4}$$
 м^2

Определяем максимальную индукцию, которая возникает в выбранном сердечнике с объёмом Vсерд:

$$\mathbf{B}_{m} \coloneqq \sqrt{\frac{2 \cdot P_{\Pi p} \cdot \mu \cdot \mu_{0}}{V_{\mathbf{CTAJM}} \cdot f_{\Pi p}}} = 0.495 \quad \mathsf{T} \qquad \qquad \mathbf{H}_{m} \coloneqq \frac{\mathbf{B}_{m}}{\mu \cdot \mu_{0}} = 2.811 \times 10^{3} \, \mathsf{A/M}$$

Определяем мощность,которую может рассеять трансформатор с таким сердечником. Коэффициент охлаждения αохл зависит от формы тела, от того, как она соориентирована в гравитационном поле, от давления, влажности и т.д.

$$\alpha_{OXII} := 20 \text{ BT/K*M}^2$$

Максимальная температура обмоток: $T_{\text{обмmax}} := 403 \text{ K}$

Допустимый перегрев: $\Delta T := T_{ofmmax} - T_{mmax} = 60$ K

Тепловое сопротивление: $R_{\rm T} := \frac{1}{\alpha_{\rm OXT} \cdot S_{\rm OXT}} = 106.458 {\rm OM}$

$$P_{pac} := \frac{\Delta T}{R_{_T}} = 0.564$$
 BT

Определяем потери мощности на перемагничивание сердечника.

Параметры апроксимации: $\alpha := 1.48$ $\beta := 1.85$

Удельные магнитные потери: $P_0 := 2000$ Bт/м^3

$$P_{\Pi c} := P_0 \cdot \left(\frac{f_{\Pi p}}{1000}\right)^{\alpha} \cdot \left(\frac{B_m - B_r}{2}\right)^{\beta} \cdot V_{\text{стали}} = 0.031$$
 Вт

Определяем допустимую мощность в обмотках трансформатора:

$$P_{\Pi O} := P_{D O} - P_{\Pi C} = 0.533$$
 Br

Рпо > 0, значит частота преобразования, максимальная индукция и размер сердечника выбраны правильно.

Определяем число витков первичной обмотки трансформатора.

Максимальный коэффициент заполнения управляющих импульсов: $_{{
m K3}_{
m max}} := 0.5$

$$I_{\text{Harmax}} \coloneqq 2 \cdot \frac{P_{\Pi p}}{E_{\Pi min} \cdot ^{\text{K3}} max} = 1.058 \text{ A} \qquad \qquad W_1 \coloneqq \frac{E_{\Pi min} \cdot ^{\text{K3}} max}{f_{\Pi p} \cdot S_{\text{CTAJII}} \cdot B_m} = 83.471$$

$$W_1 := 84$$

Определяем число витков вторичных обмоток трансформатора. Число витков вторичной обмотки канала питания нагрузки:

$$W_2 := \frac{\left(U_H + 0.7\right) \cdot \left(1 - \kappa_{3max}\right)}{f_{\Pi p} \cdot S_{\text{CTAJII}} \cdot B_m} = 10.058$$

$$W_2 := 11$$

Число витков вторичной обмотки канала питания микросхемы:

$$W_4 := \frac{\left(U_{MH} + 0.7\right) \cdot \left(1 - \kappa_{3max}\right)}{f_{\Pi p} \cdot S_{CTAJH} \cdot B_m} = 10.058$$

$$W_4 := 11$$

Индуктивность обмоток трансформатора: $L_1 := \mu_0 \cdot \mu \cdot \frac{s_{\text{стали}} \cdot {w_1}^2}{l_{\text{cp}}} = 5.927 \times 10^{-4}$ Гн

$$L_2 := \mu_0 \cdot \mu \cdot \frac{S_{\text{стали}} \cdot W_2^2}{l_{\text{cp}}} = 1.016 \times 10^{-5}$$
 Гн

$$L_3 := \mu_0 \cdot \mu \cdot \frac{S_{\text{CTAJIM}} \cdot W_4^2}{l_{\text{CD}}} = 1.016 \times 10^{-5} \text{ FH}$$

Мощность потерь в обмотках трансформатора: $P_1 := \frac{P_{\Pi O} \cdot P_{\Pi p}}{\left(P_{\Pi D} + P_H\right)} = 0.288$ Вт

$$P_2 := rac{P_{\Pi O} \cdot rac{I_H}{2} \cdot U_H}{P_{\Pi D} + P_H} = 0.122$$
 Bt

$$P_3 := \frac{P_{\Pi O} \cdot I_{MH} \cdot U_H}{P_{\Pi D} + P_H} = 1.34 \times 10^{-3}$$
 BT

$$P_{\text{CVM}} := P_1 + 2P_2 + P_3 = 0.533$$
 Bt $P_{\text{IIO}} = 0.533$ Bt

Рсум = Рпо, следовательно расчёты верны.

Максимально допустимые сопротивления обмоток: $R_{oб1} := \frac{3 \cdot P_1}{\left(\frac{P_{\Pi p}}{E_{-} \cdot \kappa_{3}_{max}}\right)^2} = 6.304$ Ом $R_{oб2} := \frac{3 \cdot P_2}{\left(\frac{P_{\Pi p}}{E_{\Pi} \cdot \kappa_{3}_{max}}\right)^2} = 2.665$ Ом $R_{oб4} := \frac{3 \cdot P_3}{\left(\frac{P_{\Pi p}}{E_{\Pi} \cdot \kappa_{3}_{max}}\right)^2} = 0.029$ Ом

Удельное сопротивление меди: $\rho := 0.0175 \cdot 10^{-6} \, \text{Ом*м}$

Определяем площади поперечных сечений и диаметры проводов всех обмоток трансформатора.

$$\begin{split} \mathbf{S}_1 &\coloneqq \frac{\rho \cdot \mathbf{W}_1 \cdot \mathbf{I}_o}{R_{o61}} = 3.731 \times 10^{-9} \quad \text{M}^2 \\ \mathbf{S}_2 &\coloneqq \frac{\rho \cdot \mathbf{W}_2 \cdot \mathbf{I}_o}{R_{o62}} = 1.156 \times 10^{-9} \quad \text{M}^2 \\ \mathbf{S}_4 &\coloneqq \frac{\rho \cdot \mathbf{W}_4 \cdot \mathbf{I}_o}{R_{o64}} = 1.051 \times 10^{-7} \quad \text{M}^2 \\ \end{split}$$

Выбираем провод ПЭТ-155. Диаметры проводов марки ПЭТ-155

Сечение проводов с изоляцией:

$$S_1 := \frac{\pi \cdot d_{1i}^2}{4} = 1.227 \times 10^{-8} \text{ M}^2$$

$$S_2 := \frac{\pi \cdot d_{2i}^2}{4} = 1.227 \times 10^{-8} \text{ m}^2$$

$$S_4 := \frac{\pi \cdot d_{4i}^2}{4} = 1.227 \times 10^{-8} \text{ m}^2$$

Размещение проводов с изоляцией

$$K_{30KHa} := 0.5$$

$$S_{OGM\Sigma} := \frac{S_1 \cdot W_1 + S_2 \cdot W_2 \cdot 2 + S_4 \cdot W_4}{K_{3OKHA}} = 2.872 \times 10^{-6}$$

$$S_{OKHa} = 3.848 \times 10^{-5}$$

$$S_{OKHA} - S_{OOM} = 3.561 \times 10^{-5}$$

Максимальный ток и напряжение МДП транзистора

$$U_{Tp} := E_{IImax} + U_{H} \cdot \frac{W_{1}}{W_{2}} = 218.227 \text{ B}$$
 $I_{Tp} := 1.2 \cdot I_{Harmax} = 1.27 \text{ A}$

Выбираем КП751Б. Аналог - IRF720.

Напряжение сток-исток: $U_{cumax} := 350$ В

Ток сток-исток: $I_{cmax} := 3.3$ A

Напряжение затвор-исток: $U_{3\mu max} := 20$ В

Сопротивление сток-исток в открытом состоянии: $R_{\text{сиост}} := 1.8$ Ом

Пороговое напряжение: $U_{\text{пормах}} := 4 \ \mathsf{B}$

Крутизна BAX: $S_{min} := 1.7$ A/B

Входная ёмкость: $C_{iss} := 600 \cdot 10^{-12} \Phi$

Выходная ёмкость: $C_{OSS} := 180 \cdot 10^{-12} \Phi$

Проходная ёмкость: $C_{rss} := 70 \cdot 10^{-12} \Phi$

Ёмкость затвор-сток: $C_{2c} := C_{res} = 7 \times 10^{-11} \Phi$

Ёмкость сток-исток: $C_{\text{CM}} := C_{\text{OSS}} - C_{3\text{C}} = 1.1 \times 10^{-10} \ \Phi$

Ёмкость затвор-исток: $C_{3M} := C_{1SS} - C_{3C} = 5.3 \times 10^{-10}$ Ф

Предельно допустимая температура: $T_{maxyt1} := 573 \, \text{K}$

Чтобы транзистор пропускал ток Інагтах, необходимо чтобы выполнялось следующее условие: Uзирас < Uзи, т.е. Uзирас < 20 B.

 $U_{3upac} := U_{\Pi opmax} + \frac{I_{Harmax}}{S_{min}} = 4.622 \quad B$

Расчёт сопротивления на затворе: $R_8 := \frac{U_{\text{выхmax}}}{I_{\text{выхmax}}} = 5 \text{ Om } R_8 := 5.1 \text{ Om}$

$$P_{R8} := I_{RHXmax}^{2} \cdot R_{8} = 5.1$$
 Bt

Расчёт диодов выходного фильтра:

$$U_{vd8} := \left(U_H + E_{IImax} \cdot \frac{W_2}{W_1}\right) \cdot 1.5 = 42.866 \text{ B}$$
 $I_{vd8} := 1.5 \cdot I_H = 3 \text{ A}$

Выбираем диод КД217A: $U_{\text{обр8}} := 100 \text{ B}$ $I_{\text{пр8}} := 3 \text{ A}$ $U_{\text{прvd8}} := 1.4 \text{ B}$ $T_{\text{maxvd8}} := 398$ К

Расчёт диода канала подпитки микросхемы:

$$\mathbf{U_{vd5}} := \left(\mathbf{U_{MH}} + \mathbf{E_{IImax}} \cdot \frac{\mathbf{W_4}}{\mathbf{W_1}} \right) \cdot 1.5 = 42.866 \ \mathbf{B} \\ \mathbf{I_{vd5}} := 2 \cdot \mathbf{I_{MH}} = 0.022 \ \mathbf{A}$$

Выбираем диод КД103A: $U_{00p5} := 50~$ В $I_{\pi p5} := 0.1~$ А $U_{\pi pvd5} := 1~$ В $T_{maxvd5} := 373$ К

Расчёт ёмкости выходного фильтра:
$$C_7 := \frac{1.4 \cdot I_{\text{Hагmax}} \cdot \kappa_{3} \text{max}}{f_{\text{пр}} \cdot \Delta U_{\text{H}}} = 6.33 \times 10^{-5} \Phi$$

Согласно ряду E24: $C_7 := 68 \cdot 10^{-6} \Phi$

Найдём сопротивление резистора R11, определяющего уровень срабатывания токовой защиты:

Опорное напряжение компаратора токовой защиты: $U_{R11} \coloneqq 1 \; \mathsf{B}$

$$R_{11} := \frac{U_{R11}}{I_{Harmax}} = 0.945 \text{ Om}$$
 $R_{11} := 1 \text{ Om}$

Рассеиваемая мощность: $P_{R4} := I_{\text{Harmax}}^{2} \cdot R_{11} = 1.119$ Вт

Время выхода ИВЭП на режим после включения микросхемы:

$$t_{BHp} := \frac{C_7 \cdot U_H}{I_H} \cdot ln \left(\frac{I_{Tp}}{I_{Tp} - I_{HA\Gamma max}} \right) = 5.483 \times 10^{-4} \text{ c}$$

Ёмкость конденсатора С1 пускового узла питания: $C_1 := \frac{I_{\text{MH}} \cdot t_{\text{BHp}}}{\Delta U_{\Gamma} \cdot 3} = 2.513 \times 10^{-6} \Phi$

$$C_1 := 2.7 \cdot 10^{-6} \Phi$$

Сопротивление резистора R2 пускового узла питания: $R_2 := \frac{0.8 \cdot E_{\pi min}}{I_{\pi vck}} = 1.288 \times 10^5$ Ом

$$R_2 := 0.13 \cdot 10^6$$
 Om

Рассеиваемая мощность: $P_{R2} := \left(2 \cdot I_{\Pi V C K}\right)^2 \cdot R_2 = 0.13$ Вт

Общее время готовности к работе:
$$t_{OB\Gamma} := t_{BHP} + \frac{R_2 \cdot C_1 \cdot U_{BK\Pi}}{E_{TIMIP}} = 0.07$$
 с

Определяем сопротивление резисторов датчика выходного напряжения.

Ток делителя через резисторы R3 и R4: $I_{\text{дел}} := 500 \cdot I_{\text{выхмах л}} = 1 \times 10^{-3}$

$$R_4 \coloneqq \frac{U_{oH}}{I_{\text{Дел}}} = 2.5 \times 10^3 \quad \text{Om} \qquad \qquad R_3 \coloneqq \frac{U_{\text{MH}} - U_{oH}}{I_{\text{Дел}}} = 6.5 \times 10^3 \quad \text{Om}$$

$$R_4 := 2.4 \cdot 10^3$$
 Om $R_3 := 6.8 \cdot 10^3$ Om

$$P_{R4} := I_{nen}^{2} \cdot R_{4} = 2.4 \times 10^{-3}$$
 Bt $P_{R3} := I_{nen}^{2} \cdot R_{3} = 6.8 \times 10^{-3}$ Bt

Определяем ёмкость C4 узла обратной связи. Чтобы не было ложного срабатывания, пульсации напряжения должны быть как можно меньше. Потому и постоянная времени цепи C4-R3-R4 должна быть минимум на порядок больше периода преобразования.

$$t_{\Pi p} := 50 \cdot \frac{1}{f_{\Pi p}} = 7.692 \times 10^{-4} \text{ c}$$

$$C_4 := \frac{t_{\Pi p}}{R_3 + R_4} = 8.361 \times 10^{-8} \qquad \Phi$$

$$C_4 := 91 \cdot 10^{-9} \Phi$$

Найдём коэффициент передачи УСР, исходя из требуемой точности стабилизации выходного напряжения:

$$K_{\text{YCP}} \coloneqq \frac{\left(U_{\text{H}} - \delta U_{\text{E}}\right) \cdot \left(R_{3} \cdot R_{4}\right)}{\delta U_{\text{E}} \cdot R_{4} \cdot \frac{W_{4} \cdot \kappa_{3}_{\text{max}} \cdot E_{\Pi}}{W_{1} \cdot \left(1 - \kappa_{3}_{\text{max}}\right) \cdot U_{\text{ампл}}} = 3.447 \times 10^{5}$$

Определяем R9 и C5 для датчика тока R4:

$$100 \cdot R_4 = 2.4 \times 10^5$$
 $R_9 > 100 \cdot R_4$

$$U_{R4} > 100 \cdot I_{вых max д} \cdot R_3$$

$$R_9 := \frac{U_{R11}}{100 \cdot I_{RHXMAXJI}} = 5 \times 10^3 \text{OM}$$

$$R_0 := 5.1 \cdot 10^3$$
 Om

$$P_{RQ} := I_{RIVMAVI}^2 \cdot R_Q = 2.04 \times 10^{-8} \text{ Bt}$$

Время включения транзистора:

$$t_{\text{BKTp}} \coloneqq \frac{U_{\text{Bыxmax}} \cdot C_{\text{3H}} + C_{\text{3C}} \cdot \left(U_{\text{Tp}} - U_{\text{Bыxmax}}\right)}{\frac{U_{\text{Bыxmax}}}{R_{\text{Q}}}} = 1.793 \times 10^{-5} \text{c}$$

$$C_5 := \frac{t_{BKTP}}{3 \cdot R_3} = 8.788 \times 10^{-10} \Phi$$
 $C_5 := 1.2 \cdot 10^{-9} \Phi$

Расчёт защитной RCD-цепи.

$$\Delta U_{\text{сил}} \coloneqq 10$$
 В

$$C_8 := \frac{0.03 \cdot B_m^{\ 2} \cdot V_{\text{CTAJIU}}}{\mu \cdot \mu_0 \cdot \left[\left(U_{\text{Tp}} + \Delta U_{\text{CUJI}} \right)^2 - U_{\text{Tp}}^{\ 2} \right]} = 4.402 \times 10^{-9} \quad \Phi$$

$$C_8 := 4.7 \cdot 10^{-9} \Phi$$

$$R_7 \coloneqq \frac{ \left[\left[E_{\Pi min} + \left(U_H + U_{\Pi pvd8} \right) \cdot \frac{W_1}{W_2} \right] + \left(U_{MH} + U_{\Pi pvd5} \right) \cdot \frac{W_1}{W_4} \right] }{ C_8 \cdot \Delta U_{\text{CMJ}} \cdot f_{\Pi p} } = 7.734 \times 10^4 \quad \text{OM}$$

$$R_7 := 82 \cdot 10^3$$
 OM

Потери в резисторе R8:

$$\mathbf{E}_{pnom} \coloneqq \mathbf{E}_{\Pi} - \mathbf{U}_{R11} - \mathbf{I}_{\mathsf{HAFMAX}} \cdot \mathbf{R}_{\mathsf{CHOCT}} = 112.096 \mathsf{B}$$

$$P_{R8} := C_8 \cdot E_{pnom} \cdot \Delta U_{cил} \cdot f_{\Pi p} = 0.342$$
 Вт

Диод в RCD-цепи:

$$\label{eq:UVD706p} U_{VD706p} > 1.5 \cdot U_{Tp} \qquad \qquad 1.5 \cdot U_{Tp} = 327.341 \quad \mathsf{B}$$

Выбираем диод КД202М:
$$I_{VD7\pi p} \coloneqq 9 \quad \text{A} \qquad \qquad U_{VD7o6p} \coloneqq 350 \quad \text{B}$$

$$U_{VD7\pi p} \coloneqq 0.9 \quad \text{B} \qquad \qquad P_{\Theta VD7} \coloneqq 276.65 \qquad \text{K/BT}$$

$$T_{maxvd7} \coloneqq 403 \quad \text{K}$$

В результате моделирования были получены следующие значения элементов:

Резисторы [Ом]:	$R_1 := 1$	С2-33Н-2Вт	P _{R1доп} := 2	Вт
	$R_2 := 51 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.25Вт	$P_{R2доп} := 0.25$	Вт
	$R_3 := 5.1 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.125Вт	$P_{R3доп} := 0.125$	Вт
	$R_4 := 1 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.125Вт	$P_{R4доп} := 0.125$	Вт
	$R_5 := 270$	С2-33Н-0.125Вт	$P_{R5доп} := 0.125$	Вт
	$R_6 := 100 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.125Вт	$P_{R6доп} := 0.125$	Вт
	$R_7 := 10 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.125Вт	$P_{R7доп} := 0.125$	Вт
	$R_8 := 15$	С2-33Н-0.125Вт	$P_{R8доп} := 0.125$	Вт
	$R_9 := 5.1 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.125Вт		
	$R_{10} := 2 \cdot 10^3$	С2-33Н-0.125Вт	$P_{R9доп} := 0.125$	Вт
	$R_{10} := 2.10$		$P_{R10\text{доп}} := 0.125$	Вт
	$R_{11} := 1$	С2-33Н-1Вт	P _{R11доп} := 1	Вт
	$R_{12} := 4.3$	KNP-20Bt	$P_{R12доп} := 20$	Вт
	$R_{13} := 4.3$	KNP-20Bt	P _{R13доп} := 20	Вт
			КТЭДОП	
Конденсаторы [Ф]	$: C_1 := 22 \cdot 10^{-6}$	K50-35	U _{С1ном} := 450 В	
	$C_2 := 3 \cdot 10^{-6}$	К73-17 имп.	$U_{C2HOM} := 400$ B	
	$C_3 := 1 \cdot 10^{-9}$	К10-17Б	$U_{C3HOM} := 50$ B	
	$C_4 := 20 \cdot 10^{-12}$	К10-17Б	$U_{C4_{HOM}} := 50$ B	
	$C_5 := 10 \cdot 10^{-9}$	К10-17Б	$U_{C5HOM} := 50$ B	
	$C_6 := 100 \cdot 10^{-9}$	К10-17Б	$U_{C6Hom} := 50$ B	
	$C_7 := 10 \cdot 10^{-9}$	К10-17Б	$U_{C7_{HOM}} := 50$ B	
	$C_8 := 0.1 \cdot 10^{-9}$	К10-17-3Б	U _{С8ном} := 160 В	
	$C_9 := 0.62 \cdot 10^{-3}$	K50-35	$U_{C9_{HOM}} := 25$ B	
	$C_{10} := 0.62 \cdot 10^{-3}$			

Энергетический расчёт

Энергетический расчёт проводим следующим образом: используя OrCAD PSpice, смотрим мощность потерь всех элементов, на которых эти потери возможны. В результате имеем следующие значения мощности потерь [Вт]:

В силовом транзисторе: $P_{M1} := 1.6$

В ШИМ-контроллере: $P_{U1} := 169 \cdot 10^{-3}$

В диодах:

$$P_{D1} := 300 \cdot 10^{-3}$$
 $P_{D2} := 160 \cdot 10^{-3}$ $P_{D3} := 160 \cdot 10^{-3}$ $P_{D4} := 300 \cdot 10^{-3}$ $P_{D5} := 18 \cdot 10^{-3}$ $P_{D6} := 10^{-3}$ $P_{D7} := 1.25 \cdot 10^{-3}$ $P_{D8} := 3$ $P_{D9} := 3$

Суммарные потери на диодах:

$$P_D := P_{D1} + P_{D2} + P_{D3} + P_{D4} + P_{D5} + P_{D6} + P_{D7} + P_{D8} + P_{D9} = 6.94$$

В резисторах:

$$\begin{aligned} & P_{R2} \coloneqq 155 \cdot 10^{-3} & P_{R3} \coloneqq 26 \cdot 10^{-3} & P_{R4} \coloneqq 7.4 \cdot 10^{-3} & P_{R5} \coloneqq 7.45 \cdot 10^{-6} & P_{R6} \coloneqq 385 \cdot 10^{-6} \\ & P_{R7} \coloneqq 61 \cdot 10^{-3} & P_{R8} \coloneqq 2.15 \cdot 10^{-3} & P_{R9} \coloneqq 145 \cdot 10^{-6} & P_{R10} \coloneqq 20.7 \cdot 10^{-3} & P_{R11} \coloneqq 940 \cdot 10^{-3} \end{aligned}$$

Суммарные потери на резисторах:

$$P_R := P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} + P_{R5} + P_{R6} + P_{R7} + P_{R8} + P_{R9} + P_{R10} + P_{R11}$$

$$P_R = 1.213$$

Суммарные потери ИВЭП:
$$P_{MBЭ\Pi} := P_{M1} + P_{U1} + P_D + P_R = 9.922$$

КПД устройства:
$$\eta_{\text{уст}} \coloneqq \frac{P_{\text{H}}}{P_{\text{H}} + P_{\text{ИВЭ}\Pi}} = 0.646$$

Расчёт показателей надёжности

Резисторы

$$K_{IR} := 1$$
 $K_{UR} := 1$ $K_{E} := 1$ $\lambda_{0R} := 0.087 \cdot 10^{-6}$ 1/4 $T_{0} := 298$ K $T_{pa6} := 343$ K

Коэффициенты интенсивности отказов:

$$\begin{split} K_{PR2} &\coloneqq \frac{P_{R2}}{P_{R2 \# O \Pi}} = 0.62 & K_{PR7} \coloneqq \frac{P_{R7}}{P_{R7 \# O \Pi}} = 0.488 \\ K_{PR3} &\coloneqq \frac{P_{R3}}{P_{R3 \# O \Pi}} = 0.208 & K_{PR8} \coloneqq \frac{P_{R8}}{P_{R8 \# O \Pi}} = 0.017 \\ K_{PR4} &\coloneqq \frac{P_{R4}}{P_{R4 \# O \Pi}} = 0.059 & K_{PR9} \coloneqq \frac{P_{R9}}{P_{R9 \# O \Pi}} = 1.16 \times 10^{-3} \\ K_{PR5} &\coloneqq \frac{P_{R5}}{P_{R5 \# O \Pi}} = 5.96 \times 10^{-5} & K_{PR10} \coloneqq \frac{P_{R10}}{P_{R10 \# O \Pi}} = 0.166 \\ K_{PR6} &\coloneqq \frac{P_{R6}}{P_{R6 \# O \Pi}} = 3.08 \times 10^{-3} & K_{PR11} \coloneqq \frac{P_{R11}}{P_{R11 \# O \Pi}} = 0.94 \end{split}$$

$$K_{PR} = 2.502$$

$$K_T := \frac{T_{pa6}}{T_0} = 1.151$$

Интенсивоности отказов элементов (1/ч): $\lambda_R := \lambda_{0R} \cdot K_{IR} \cdot K_{UR} \cdot K_E \cdot K_{PR} \cdot K_T = 2.506 \times 10^{-7}$

Конденсаторы

$$K_{IC} := 1$$
 $K_{PC} := 1$ $K_E := 1$ $K_E := 1$ $K_C := 298$ $K_C := 103$ $K_C :$

Коэффициенты интенсивности отказов:

$$\begin{split} K_{UC1} &\coloneqq \frac{U_{C1}}{U_{C1\text{HOM}}} = 0.229 \\ K_{UC2} &\coloneqq \frac{U_{C2}}{U_{C2\text{HOM}}} = 0.04 \\ K_{UC2} &\coloneqq \frac{U_{C7}}{U_{C7\text{HOM}}} = 0.018 \\ K_{UC3} &\coloneqq \frac{U_{C3}}{U_{C3\text{HOM}}} = 0.26 \\ K_{UC3} &\coloneqq \frac{U_{C8}}{U_{C8\text{HOM}}} = 0.625 \\ K_{UC4} &\coloneqq \frac{U_{C4}}{U_{C4\text{HOM}}} = 0.34 \\ K_{UC9} &\coloneqq \frac{U_{C9}}{U_{C9\text{HOM}}} = 0.36 \\ K_{UC10} &\coloneqq \frac{U_{C10\text{HOM}}}{U_{C10\text{HOM}}} = 0.36 \end{split}$$

Электролитические конденсаторы:

$$\lambda_{0{\rm C}_{\rm ЭЛ}} \coloneqq 0.35 \cdot 10^{-6}$$
 1/ч
$${\rm K}_{{\rm U}{\rm C}_{\rm ЭЛ}} \coloneqq {\rm K}_{{\rm U}{\rm C}_{\rm 1}} + {\rm K}_{{\rm U}{\rm C}_{\rm 9}} + {\rm K}_{{\rm U}{\rm C}_{\rm 10}} = 0.949$$

Интенсивоности отказов элементов (1/ч):

$$\lambda_{\text{C}\ni\pi} \coloneqq \lambda_{0\text{C}\ni\pi} \cdot K_{\text{IC}} \cdot K_{\text{UC}\ni\pi} \cdot K_{\text{E}} \cdot K_{\text{PC}} \cdot K_{\text{T}} = 3.823 \times 10^{-7}$$

Керамические конденсаторы:

$$\lambda_{0\text{Ckep}} := 0.15 \cdot 10^{-6}$$
 1/4

$$K_{UCKep} := K_{UC3} + K_{UC4} + K_{UC5} + K_{UC6} + K_{UC7} + K_{UC8} = 1.383$$

Интенсивоности отказов элементов (1/ч):

$$\lambda_{C\kappa ep} := \lambda_{0C\kappa ep} \cdot K_{IC} \cdot K_{UC\kappa ep} \cdot K_{E} \cdot K_{PC} \cdot K_{T} = 2.388 \times 10^{-7}$$

Плёночные конденсаторы:

$$\lambda_{0C_{\Pi\Pi}} := 0.05 \cdot 10^{-6}$$
 1/4

$$K_{UC\Pi JI} := K_{UC2} = 0.04$$

Интенсивоности отказов элементов (1/ч):

$$\lambda_{C\pi\pi} \coloneqq \lambda_{0C\pi\pi} \cdot K_{IC} \cdot K_{UC\pi\pi} \cdot K_E \cdot K_{PC} \cdot K_T = 2.302 \times 10^{-9}$$

$$\lambda_{\text{C}} := \lambda_{\text{C} \ni \pi} + \lambda_{\text{CKEP}} + \lambda_{\text{C} \Pi \Pi} = 6.234 \times 10^{-7}$$

Тепловой расчёт

Максимальная рабочая температура теплонагруженных элементов [К]; должна быть на 20% меньше предельно допустимой температуры элементов:

$$T_{ivd8} := T_{maxvd8} - \frac{T_{maxvd8}}{5} = 318.4$$

$$T_{ivd5} := T_{maxvd5} - \frac{T_{maxvd5}}{5} = 298.4$$

$$T_{ivd7} := T_{maxvd7} - \frac{T_{maxvd7}}{5} = 322.4$$

$$T_{ivt1} := T_{maxvt1} - \frac{T_{maxvt1}}{5} = 458.4$$

$$T_{i_{M}} := T_{Mmax} - \frac{T_{mmax}}{5} = 274.4$$

 $K_{PR} \coloneqq K_{PR2} + K_{PR3} + K_{PR4} + K_{PR5} + K_{PR6} + K_{PR7} + K_{PR8} + K_{PR9} + K_{PR10} + K_{PR11}$